

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年3月27日(2008.3.27)

【公表番号】特表2007-531281(P2007-531281A)

【公表日】平成19年11月1日(2007.11.1)

【年通号数】公開・登録公報2007-042

【出願番号】特願2007-505127(P2007-505127)

【国際特許分類】

H 01 L 21/76 (2006.01)

H 01 L 21/822 (2006.01)

H 01 L 27/04 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/76 L

H 01 L 27/04 H

H 01 L 27/04 A

【手続補正書】

【提出日】平成20年2月7日(2008.2.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体基板と、

前記半導体基板の上の埋込絶縁層と、

前記埋込絶縁層の上の半導体メサと、

前記半導体メサを実質的に囲むガード・リングと、を備え、

前記ガード・リングは、前記半導体基板と接触し、前記半導体メサに対してRF分離を与えるよう構成されている、

集積回路。

【請求項2】

前記半導体基板は、高抵抗率の半導体基板を含む、請求項1に記載の集積回路。

【請求項3】

前記半導体基板は、シリコン基板を含み、

前記埋込絶縁層は、埋込シリコン酸化物層を含み、

前記半導体メサは、シリコン・メサを含む、

請求項1に記載の集積回路。

【請求項4】

前記半導体基板は、前記ガード・リングにより接触されている範囲にドーピングされている、請求項1に記載の集積回路。

【請求項5】

前記ガード・リングは、低抵抗率のガード・リングを含む、請求項1に記載の集積回路。

【請求項6】

前記ガード・リングは、金属ガード・リングを含む、請求項1に記載の集積回路。

【請求項7】

前記金属ガード・リングは、タンゲステン・ガード・リングを含む、請求項6に記載の

集積回路。